Fraunhofer-Institut für Integrierte Systeme und Bauelementetechnologie IISB, Erlangen Lehrstuhl für Elektronische Bauelemente Universität Erlangen-Nürnberg





Kolloquium zur Halbleitertechnologie und Leistungselektronik

Gemeinsames Kolloquium zur Halbleitertechnologie und Messtechnik in Kombination mit der Veranstaltungsreihe "Leistungselektronik" (öffentliche Veranstaltungsreihe des Fraunhofer-Innovationsclusters Elektronik für nachhaltige Energienutzung)

Veranstaltungen Wintersemester 2014/15

Beginn der Veranstaltungen jeweils um 17:15 Uhr Ort: Hans-Georg-Waeber-Saal, Fraunhofer IISB, Schottkystraße 10, Erlangen

Mo., 06.10.14	Versetzungen in hoch dotiertem CZ-Silizium Ludwig Stockmeyer, Energiematerialien THM, Freiberg
Mo., 20.10.14	Themenschwerpunkt Leistungselektronik
Mo., 27.10.14	Lessons learned from APC-data collection in Malaysia Felix Klingert, Fraunhofer IISB, Erlangen
Mo., 17.11.14	Wiederverwendbare Si3N4-Tiegel Veronika Schneider, <i>Fraunhofer IISB, Erlangen</i>
Mo., 24.11.14	Themenschwerpunkt Leistungselektronik
Mo., 01.12.14	Optimierung optischer Gitter für LED-basierte gewerbliche und Architektur-Beleuchtungsmodule Peter Evanschitzky, Fraunhofer IISB, Erlangen
Mo., 08.12.14	Der Einsatz von Brennstoffzellen zur Verwertung von wasserstoffhaltigen Gasgemischen Michael Steinberger, <i>Fraunhofer IISB, Erlangen</i>
Mo., 15.12.14	Themenschwerpunkt Leistungselektronik

Seite 1 Stand: 30.09.2014

Fraunhofer-Institut für Integrierte Systeme und Bauelementetechnologie IISB, Erlangen Lehrstuhl für Elektronische Bauelemente Universität Erlangen-Nürnberg







Gemeinsames Kolloquium zur Halbleitertechnologie und Messtechnik in Kombination mit der Veranstaltungsreihe "Leistungselektronik" (öffentliche Veranstaltungsreihe des Fraunhofer-Innovationsclusters Elektronik für nachhaltige Energienutzung)

Veranstaltungen Wintersemester 2014/15

Beginn der Veranstaltungen jeweils um 17:15 Uhr Ort: Hans-Georg-Waeber-Saal, Fraunhofer IISB, Schottkystraße 10, Erlangen

Mo., 12.01.15	BiFET - Entwicklung eines bipolaren HV-Schalters spezifisch für 4H-SiC Andreas Hürner, Fraunhofer IISB, Erlangen
Mo., 19.01.15	Strukturelle Untersuchungen an GaN Michael Knetzger, Fraunhofer IISB, Erlangen
Mo., 26.01.15	Themenschwerpunkt Leistungselektronik

Seite 2 Stand: 30.09.2014